



	English	中文	交通アクセス・地図	お問い合わせ	サイトマップ	サイト内検索
	受験生の方	広大へ留学希望の方	一般・地域の方	企業の方	卒業生の方	在学生・保護者の方

大学案内

入試情報

教育・学生生活

研究

社会連携

留学・国際交流

学部・大学院等

研究所・施設等

広報・報道

採用情報

校友会・同窓会

支援財団・基金

図書館・博物館等

大学病院

附属学校

[トップページ](#) > [広報・報道](#) > [報道発表・報道された広島大学](#) > [平成20年1月-12月](#) > 日本発の高耐圧トランジスタモデル HiSIM-LDMOSが国際標準へ！

日本発の高耐圧トランジスタモデル HiSIM-LDMOSが国際標準へ！

2008年1月吉日
NEDO技術開発機構
電子・情報技術開発部

記者説明会のご案内

日本発の高耐圧トランジスタモデル
HiSIM-LDMOSが国際標準へ！

～情報家電・自動車などの低消費電力化によりエコ社会を拓く～

このたび、国立大学法人広島大学と株式会社半導体理工学研究センターが開発し、経済産業省／NEDO技術開発機構が支援を行ってきたトランジスタモデル「HiSIM-LDMOS」が、我が国で開発されたモデルとして初めて国際標準化機関CMC (Compact Model Council)において、国際標準モデルに選定されました。
本モデルを使用することで半導体回路シミュレーションの精度が向上します。これにより、例えば、情報家電等に用いられている高耐圧トランジスタ搭載の半導体LSI の設計最適化が可能になり、消費電力削減効果等が期待されます。

つきましては、下記のとおり記者説明会を開催致しますので、ご出席賜りたくご案内申し上げます。

記

日時： 2008年1月17日(木) 10:30～1130 (受付開始 10:00)
会場： NEDO技術開発機構(川崎) 16階 会議室A
(16階エレベーターホール正面のNEDO 技術開発機構受付に向かって右奥の会議室です。)
〒211-8554 神奈川県川崎市幸区大宮町 1310 ミューザ川崎セントラルタワー16F
(<http://www.nedo.go.jp/introducing/shozaichi.html>)
TEL:044-520-5210(NEDO技術開発機構 電子・情報技術開発部)

出席予定者：

国立大学法人広島大学	学長 浅原利正
同 先端物質科学研究科	教授 三浦道子
同 ナノデバイス・システム研究センター	教授 H.J. Mattausch
株式会社半導体理工学研究センター 代表取締役社長	下東勝博
同 企画部部長代理／標準化推進室室長	吉井芳春
NEDO技術開発機構 電子・情報技術開発部 部長	富田健介
同 プログラムマネージャ	秦信宏

【お問い合わせ先】

・技術内容その他について
株式会社 半導体理工学研究センター 企画部 吉井芳春
TEL:045-478-3272、 FAX:045-478-3310、 E-mail: furui.yoshiharu@starc.or.jp
・発表会、会場その他について
NEDO技術開発機構 電子・情報技術開発部 齋藤博文
TEL:044-520-5210、 FAX:044-520-5212、 E-mail: saitohhrf@nedo.go.jp
(@は半角@に置き換えた上、送信してください。)

【お知らせ】

本件説明会のご案内につきましては、個別に経済産業記者会、経済産業省ベンクラブ、エネルギー記者会、文部科学記者会、科学記者会の加盟社の皆様にご案内するほか、出版社やweb など幅広いジャンルのメディアの方々にご案内しております。予めご了承下さいますようお願い申し上げます。

(備考)「NEDO技術開発機構」は、「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」の略称です。

広大公式アカウント一覧

- Twitter
- Facebook (日本語版)
- Facebook (英語版)
- YouTube
- 行事カレンダー
- ストリートビュー
- キャンパスカメラ
- 学内ポータル